

シリコンPNP三重拡散形トランジスタ

2SB434/435

単位：mm

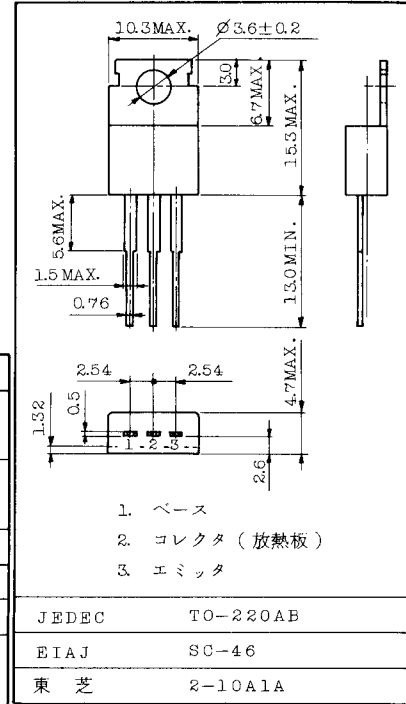
○ 低周波電力増幅用

特長

- 飽和電圧が低い。
 $V_{CE(sat)} = -1.2V$ (最大) ($I_C = -3A$ (2SB434))
 $V_{CE(sat)} = -1.0V$ (最大) ($I_C = -1A$ (2SB435))
- 許容コレクタ損失が大きい。: $P_C = 25W$ ($T_c = 25^\circ C$)
- 2SD234, 2SD235 とコンプリメンタリになります。

最大定格 ($T_a = 25^\circ C$)

項目	記号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V _{CB0}	2SB434 -50	V
2SB435 -40			
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CE0}	2SB434 -50	V
2SB435 -40			
エミッタ・ベース間電圧	V _{EB0}	-5	V
コレクタ電流	I _C	-3	A
ベース電流	I _B	-0.3	A
コレクタ損失	P _C	T _a = 25°C 1.5	W
		T _c = 25°C 25	
接合温度	T _j	150	°C
保存温度	T _{stg}	-55~150	°C



アクセサリは AC55C を通用

電気的特性 ($T_a = 25^\circ C$)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
コレクタシャ断電流	I _{CBO}	V _{CB} = -30V, I _E = 0	-	-	-10	μA
エミッタシャ断電流	I _{EBO}	V _{EB} = -5V, I _C = 0	-	-	-100	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	V _{(BR)CEO}	I _C = -100mA, I _B = 0	2SB434 -50	-	-	V
			2SB435 -40			
エミッタ・ベース間降伏電圧	V _{(BR)EBO}	I _E = 10mA, I _C = 0	-5	-	-	V
直流電流増幅率	h _{FE(1)} (注)	V _{CE} = -5V, I _C = -0.5A	40	-	240	
直流電流増幅率	h _{FE(2)}	V _{CE} = -5V, I _C = -2.5A	2SB434 15	60	-	
			2SB435 20	90	-	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C = -3A, I _B = -0.3A	2SB434 -	-0.6	-1.2	V
			2SB435 -	-0.2	-1.0	
ベース・エミッタ間電圧	V _{BE}	V _{CE} = -5V, I _C = -0.5A	-	-0.75	-0.9	V
トランジション周波数	f _T	V _{CE} = -5V, I _C = -0.5A	-	10	-	MHz
コレクタ出力容量	C _{ob}	V _{CB} = -10V, I _E = 0, f = 1MHz	-	150	-	pF

注: h_{FE(1)} 分類 R: 40~80, O: 70~140, Y: 120~240